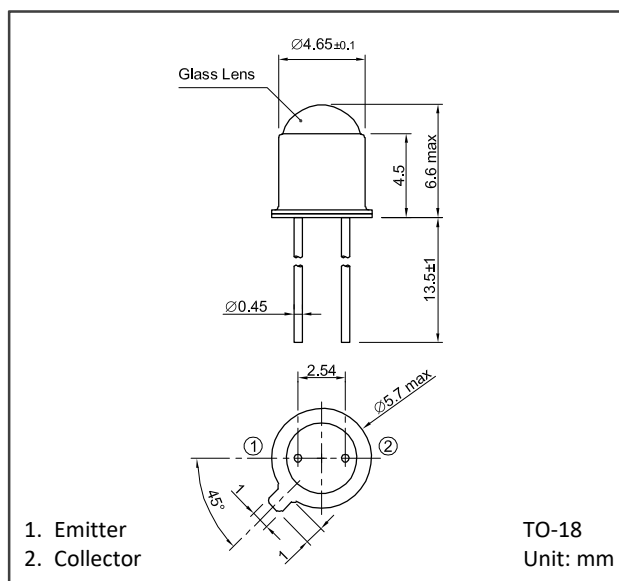


## 特長

- NPN型フォトトランジスタ
- 可視光カットタイプ
- 気密パッケージ
- 低暗電流

## 用途

- 光スイッチ
- 光学式エンコーダ
- 光アイソレータ
- カメラストロボ
- 赤外センサ
- 自動制御機器



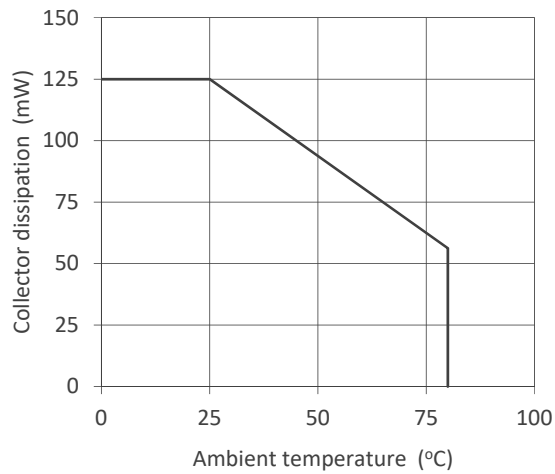
## 絶対最大定格

項目	記号	定格値	単位	備考
コレクタ-エミッタ間電圧	$V_{ce0}$	20	V	
エミッタ-コレクタ間電圧	$V_{eco}$	5	V	
コレクタ-ベース間電圧	$V_{cbo}$	-	V	
エミッタ-ベース間電圧	$V_{ebo}$	-	V	
許容損失	$P_D$	125	mW	
動作温度	$T_{opr}$	-20 to +80	°C	結露なきこと
保存温度	$T_{stg}$	-30 to +100	°C	結露なきこと

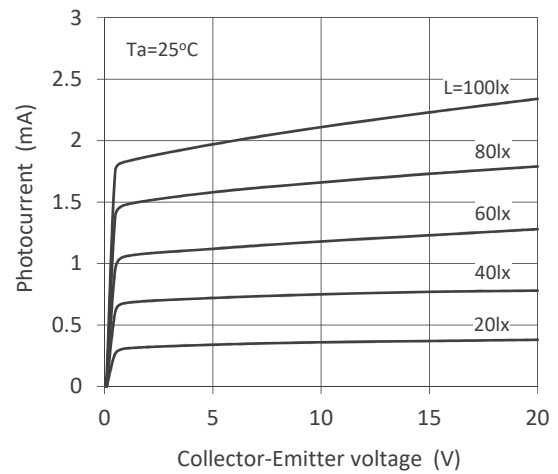
電氣的・光学的特性 (指定の無い場合  $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
有効受光面積	S	0.64 x 0.64			mm <sup>2</sup>	
検出波長	$\lambda$	700	800( $\lambda_p$ )	1100	nm	$\lambda_p$ =ピーク波長
光電流	$I_L$	-	2	-	mA	$V_{ce}=5V$ , 100lx (@2856K)
暗電流	$I_{ceo}$	-	100	200	nA	$V_{ce}=20V$
電流増幅率	$h_{FE}$	400	-	-	-	$V_{ce}=5V$ , $I_C=2mA$
コレクタ飽和電圧	$V_{ce(sat)}$	-	-	0.4	V	$I_C=0.1mA$ 100lx (@2856K)
立上り・立下り時間	$t_r, t_f$	-	5	-	$\mu s$	$V_{ce}=5V$ , $I_C=2mA$ , $R_L=100\Omega$

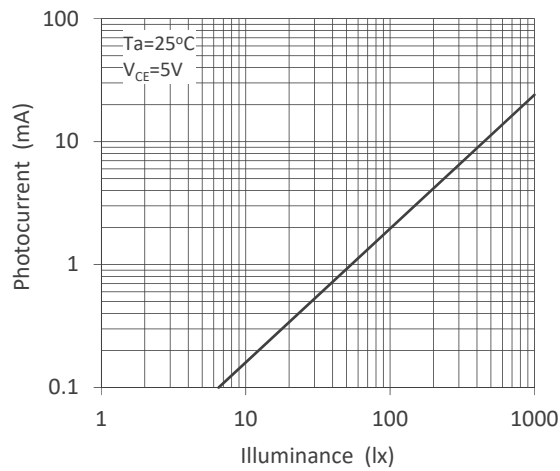
Collector Dissipation - Ambient Temperature



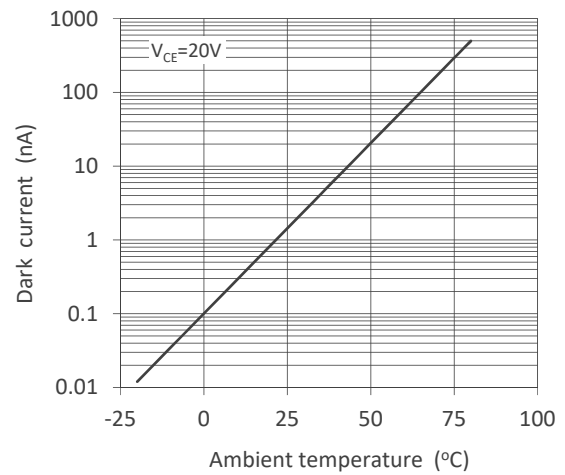
Photocurrent - Collector-Emitter Voltage



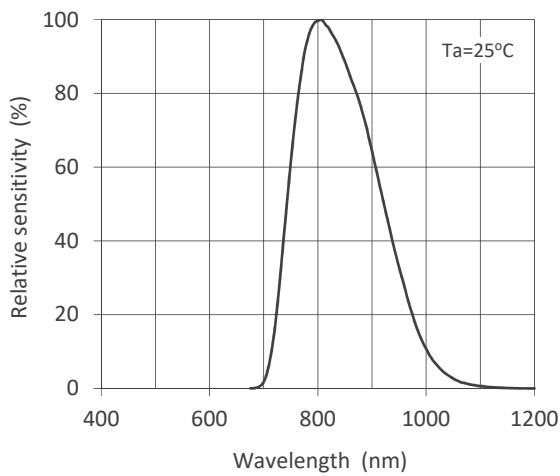
Photocurrent - Illuminance



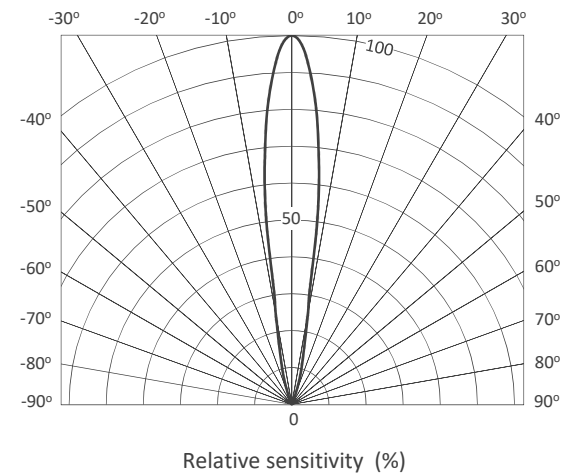
Dark Current - Ambient Temperature



Spectral Responsivity



Directivity



- 製品の仕様、特性、データ、仕様材料、構造などは変更する可能性があります。ご使用の際は、必ず最新の仕様書をご用命のうえ内容をご確認ください。
- 本製品はRoHS指令(2011/65/EU)適応品です。



**Opto-technologies for the Future**

## 株式会社 京都セミコンダクター

本社：〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307番地21

東京営業所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-3 第24スカイビル2F

関西営業所：〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307番地21

Kyosemi Opto America Corp: 4655 Old Ironsides Suite 230 Santa Clara, California 95054 USA

恵庭事業所：〒061-1405 北海道恵庭市戸磯385-31

上砂川事業所：〒073-0200 北海道空知郡上砂川町上砂川70-1

TEL: 075-605-7311

TEL: 03-5312-5360

TEL: 075-605-7314

TEL: +1-408-492-9361

TEL: 0123-34-3111

TEL: 0125-62-3611